04:09

Азимутальные поверхностные волны в замагниченной плазме

© И.А. Гирка, П.К. Ковтун

Харьковский государственный университет, 310077 Харьков, Украина

(Поступило в Редакцию 7 апреля 1997 г.)

Теоретически исследованы дисперсионные свойства поверхностных волн, распространяющихся по азимуту в замагниченных цилиндрических плазменных волноводах. Показана возможность распространения в таких волноводах поверхностных колебаний ионной компоненты.

Введение

За необыкновенными электромагнитными волнами, распространяющимися по азимуту вдоль границы плазмы в цилиндрических волноводах, закрепилось название азимутальных поверхностных волн (АПВ) [1–4]. Эти волны активно исследуются в последние годы главным образом в связи с их возможным использованием при создании приборов плазменной [5] и полупроводниковой [4] электроники. В отмеченных работах рассматривался случай плотной плазмы ($\omega_{pe}^2\gg\omega_{ce}^2$, здесь $\omega_{p\alpha}$ и $\omega_{c\alpha}$ — плазменная и циклотронная частоты частиц сорта α , $\alpha = e$ для электронов, $\alpha = i$ для ионов), частота исследованных колебаний лежит в области выше электронной циклотронной, поэтому движением ионной компоненты плазмы можно было пренебречь. Указанное соотношение между плазменной и циклотронной частотами легко может быть выполнено в плазме полупроводников, для которой характерна высокая концентрация n_e свободных электронов. Однако в лабораторной газовой плазме оно часто бывает невыполненным (в лучших экспериментах по управляемому термоядерному синтезу достигаются концентрации порядка $n_e \sim 10^{15} \, {\rm cm}^{-3}$, тем не менее использование сильного магнитного поля для удержания плазмы приводит к неравенству $\omega_{pe}^2 \lesssim \omega_{ce}^2$). В настоящей работе исследованы дисперсионные свойства АПВ именно в замагниченных $\omega_{pe}^2 \lesssim \omega_{ce}^2$ плазменных волноводах, показана возможность существования в таких волноводах поверхностных колебаний, обусловленных движением ионной компоненты.

Постановка задачи

Исследуем распространение электромагнитных волн вблизи границы однородного плазменного цилиндра радиуса a, отделенного от коаксиальной идеально проводящей металлической камеры радиуса b слоем диэлектрика с проницаемостью ε . Волновод считаем однородным вдоль оси $\partial/\partial z \equiv 0$. Внешнее постоянное магнитное поле полагаем ориентированным вдоль оси волновода $\mathbf{B}_0 \parallel \mathbf{e}_z$. Компоненты векторов электрической индукции и напряженности электрического поля \mathbf{E} -волны считаем связанными тензором диэлектрической проницаемости холодной слабостолкновительной плазмы.

В этом случае система уравнений Максвелла распадается на две независимые системы, описывающие E-волну с компонентами поля E_r , E_φ , H_z , и H-волну с компонентами H_r , H_φ E_z . Свойства H-волны не зависят от величины внешнего магнитного поля. В волноводах с узким диэлектрическим зазором ($b-a\ll a$, $b-a\ll c/\omega$) поверхностная H-волна не распространяется [2]. Поэтому мы ограничимся здесь исследованием волн E-типа. Поскольку АПВ с различными азимутальными номерами моды m распространяются независимо, то, исходя из симметрии задачи, решение уравнений Максвелла ищем для аксиальной компоненты магнитного поля АПВ в виде $H_z = H_z^{(m)}(r) \exp(im\varphi - i\omega t)$.

Компоненты электрического поля АПВ выражаются через H_z следующим образом:

$$E_r = \frac{k}{k_0^2} \left(\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1} \frac{\partial H_z}{\partial r} + \frac{m}{r} H_z \right), \tag{1}$$

$$E_{\varphi} = i \frac{k}{k_0^2} \left(\frac{\partial H_z}{\partial r} + \frac{m}{r} \frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1} H_z \right), \tag{2}$$

где $k=\omega/c$, величина k_0^{-1} определяет глубину проникновения поля в плазму, $k_0^2=(\omega/c)^2\big(\varepsilon_2^2-\varepsilon_1^2\big)/\varepsilon_1$, $\varepsilon_{1,2}$ — компоненты тензора диэлектрической проницаемости плазмы.

Вывод дисперсионного уравнения

Для компонент поля АПВ потребуем выполнения следующих граничных условий: равенство нулю тангенциальной компоненты электрического поля волны на металлической поверхности

$$E_{\varphi}(r=b) = 0; \tag{3}$$

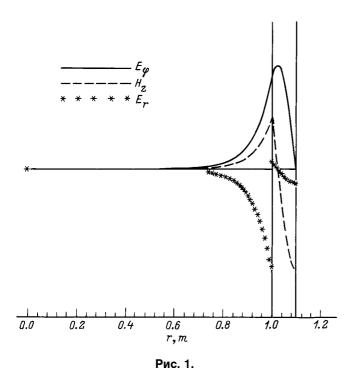
непрерывность тангенциальных компонент электрического и магнитного полей волны на границе плазмавакуум

$$E_{\varphi}(r=a+0) = E_{\varphi}(r=a-0),$$
 (4)

$$H_z(r=a+0) = H_z(r=a-0);$$
 (5)

ограниченность полей волны во всем объеме волновода и, в частности, на оси

$$H_z(r=0) < \infty. (6)$$



Из уравнений Максвелла получаем для амплитуды магнитного поля $H_z^{(m)}$ в области плазмы уравнение Бесселя, решение которого, удовлетворяющее условию (6), выражается через модифицированную функцию Бесселя $I_m(k_0r)$ порядка m

$$H_{z}^{(m)} = C_1 \cdot I_m(k_0 r), \tag{7}$$

где C_1 — нормировочный множитель.

Решение (7) имеет вид поверхностной волны при $k_0^2>0$. Отсюда следует, что АПВ могут существовать в следующих частотных диапазонах:

$$\omega_{lh} < \omega < \omega_1$$
 и $\omega_{hh} < \omega < \omega_2$, (8)

которые будем называть соответственно низкочастотным (НЧ) и высокочастотным (ВЧ). Здесь ω_{lh} , ω_{hh} — нижняя и верхняя гибридные частоты: $\omega_{1,2}=\pm 0.5\omega_{ce}+\sqrt{0.25\omega_{ce}^2-\omega_{ci}\omega_{ce}+\omega_{pe}^2}$ — частоты отсечки объемных волн [6]. В разреженной $\omega_{pe}<|\omega_{ce}|$ плазме ВЧ диапазон становится очень узким и находится вблизи электронной циклотронной частоты, величины частот АПВ в нем слабо зависят от параметров плазмы. При этом нижняя гибридная частота оказывается порядка ионной циклотронной частоты и возникают условия для существования поверхностных колебаний ионной компоненты плазмы.

В области диэлектрика магнитное поле волны выражается через линейную комбинацию функций Бесселя $J_m(\kappa r)$ и Неймана $N_m(\kappa r)$ порядка m, т.е. АПВ являются поверхностными только в плазме, в диэлектрике они

объемные

$$H_z^{(m)} = C_2 \cdot (J_m(\kappa r)N_m'(\kappa b) + J_m'(\kappa b)N_m(\kappa r)), \qquad (9)$$

где $\kappa(\omega/c)\sqrt{\varepsilon}$, C_2 — нормировочный множитель.

На рис. 1 представлены зависимости полей АПВ от радиуса волновода. При вычислениях были выбраны следующие значения параметров волновода: $n_e = 2 \cdot 10^{12} \, \mathrm{cm}^{-3}$, $B_0 = 50 \, \mathrm{kGs}$, $a = 1 \, \mathrm{m}$, $b = 1.1 \, \mathrm{m}$, m = -3. Подчеркнем, что азимутальный компонент электрического поля отличен от нуля в объеме волновода, хотя и зануляется на металлической камере. Этим топология полей в цилиндрической плазме отличается от случая распространения поверхностных волн поперек постоянного магнитного поля вдоль плоской границы плазмы [3]. Для выбранных значений параметров волновода АПВ существенно непотенциальны: электромагнитная энергия, запасенная в магнитной компоненте, немала по сравнению с энергией электрического поля волны.

Потребовав удовлетворения граничных условий (4), (5), получаем дисперсионное уравнение АПВ в виде

$$D^{(\text{pl})} = D^{(\text{vac})},\tag{10}$$

где

$$D^{(\text{pl})} = \frac{1}{k_0} \frac{I_m(k_0 a)}{I_m(k_0 a)} + \frac{m \cdot \varepsilon_2}{k_0^2 a \cdot \varepsilon_1},\tag{11}$$

$$D^{(\text{vac})} = \frac{1}{\kappa} \frac{J'_m(\kappa a) \cdot N'_m(\kappa b) - J'_m(\kappa b) \cdot N'_m(\kappa a)}{J'_m(\kappa b) \cdot N_m(\kappa a) - J_m(\kappa a) \cdot N_m(\kappa b)}.$$
 (12)

Анализ дисперсионного уравнения

В случае узкого дисперсионного зазора $(m\Lambda \ll 1, \kappa(b-a) \ll |m|$, где $\Lambda \equiv (b-a)/a)$, когда влияние параметров плазмы на дисперсионные свойства АПВ наиболее сильно, правая часть дисперсионного уравнения упрощается

$$D^{(\text{vac})} \approx (b-a) \left(\frac{m^2}{\kappa a^2} - 1\right).$$
 (13)

Отсюда видно, что в широких волноводах с узким зазором АПВ не распространяются, так как левая часть (10) положительна в силу неравенства $(k_0a\gg |m|)$, а правая отрицательна при $\omega_{lh}>(|m|c)/(a\sqrt{\varepsilon})$, в результате чего дисперсионное уравнение не имеет решения (см. также численный расчет на рис. 5).

Простое аналитическое решение уравнения (10) для АПВ в НЧ диапазоне может быть получено в случае тонкого цилиндра $\kappa b \ll 1,\,k_0 a \ll 1$

$$\frac{\omega}{\omega_{ci}} \approx 1 + \frac{|\gamma|}{|\gamma| + \varepsilon} \frac{\omega_{pi}^2}{\omega_{ci}^2},$$
 (14)

где

$$\gamma = \frac{(a/b)^{2m} - 1}{(a/b)^{2m} + 1}.$$

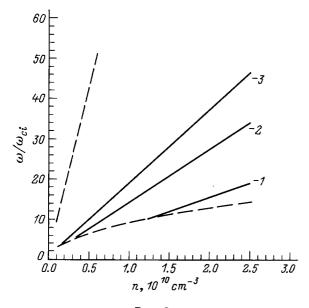


Рис. 2.

Для узкого зазора $\gamma\approx m\cdot \Lambda\ll 1$. При этом, как видно из (14), собственная частота волновода определяется не абсолютной величиной ширины диэлектрического зазора (b-a), а относительной Λ . В данном случае волны являются однонаправленными: знак азимутального волнового числа может быть только отрицательным (m<0). Направление распространения АПВ совпадает с направлением циклотронного вращения ионов, и их частота может быть порядка ионной циклотронной. АПВ распространяются в тонком цилиндре (дисперсионное уравнение (10) имеет решение в виде поверхностной волны $\omega>\omega_{lh}$), если плазма не слишком разрежена или внешнее магнитное поле не слишком велико $m_i/m_e>\omega_{pi}^2/\omega_{ci}^2\gtrsim \left\{1+(\varepsilon/|\gamma|)^2\right\}.$

Для существования АПВ вблизи границы плотная плазма-металл (b=a) необходимым условием является наличие внешнего магнитного поля [3], однако в случае тонкого замагниченного плазменного цилиндра дисперсионное уравнение не имеет решения.

В случае тонкого плазменного цилиндра $(k_0 a \ll |m|)$ АПВ можно считать потенциальными, магнитное поле волны много меньше электрического. Амплитуда электрических полей АПВ с азимутальным номером m=-1 остается практически постоянной даже в области плазмы.

Результаты численного решения дисперсионного уравнения (10) представлены на рис. 2–4. Графически показана зависимость частоты АПВ от параметров волноведущей структуры: концентрации на рис. 2, величины внешнего магнитного поля B_0 на рис. 3 и проницаемости диэлектрического зазора ε на рис. 4. При этом были выбраны следующие значения параметров волновода: для всех рисунков $a=10\,\mathrm{cm},~\Lambda=0.1,~\mathrm{для}$ рис. 2 $B_0=3000\,\mathrm{Gs},~\mathrm{концентрация}$ плазмы нормирована на $10^{10}\,\mathrm{cm}^{-3},~\mathrm{для}$ рис. 3 и 4 $n_e=10^8\,\mathrm{cm}^{-3}$ и для рис. 4

 $B_0 = 50 \, \mathrm{Gs}$. Цифрами на рисунках обозначены номера мод m, штриховыми линиями показаны границы НЧ диапазона.

В волноводах с широким диэлектрическим зазором свойства АПВ слабо зависят от параметров плазмы и определяются в основном свойствами зазора. При этом для данного азимутального номера возможно существование высших радиальных гармоник АПВ и решение уравнения (10) существует при

$$(2n+1)\frac{\pi}{2} < \frac{\omega}{c}(b-a) < (2n+2)\frac{\pi}{2},$$

 $n = 1, 2, 3 \dots, \quad \kappa a \gg |m|.$

В этом случае АПВ являются существенно непотенциальным. В широких волноводах, помещенных в сильное магнитное поле $k_0 a \gg |m|$, глубина проникновения поля

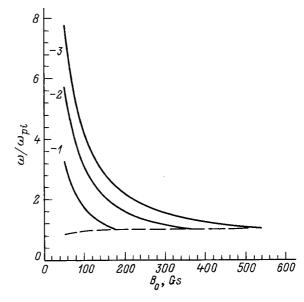


Рис. 3.

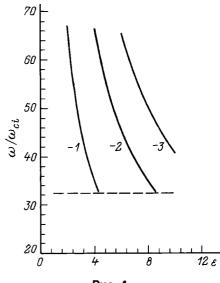
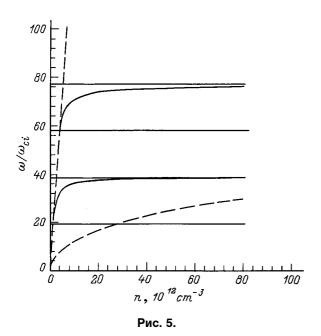


Рис. 4.



в плазму мала и аналитическое выражение для частоты n-й радиальной моды имеет вид $\omega = \omega_{0n} + \delta \omega$, где

$$\omega_{0n} = \frac{\pi n}{2} \frac{c}{b-a},$$

$$\delta\omega = \frac{k_0}{\kappa} \frac{c}{b-a} \left(1 - \frac{m\varepsilon_2}{k_0 a \varepsilon_1}\right)_{\omega = \omega_{0n}}.$$
 (15)

Для волн с малой глубиной проникновения зависимость частоты от m выражена слабо и еще сильнее спадает с увеличением концентрации плазмы. Из (15) видно, что $\delta\omega$ для положительных m больше, чем для отрицательных, и различие в частоте волн с противоположными азимутальными номерами максимально вблизи верхней границы НЧ диапазона, где $\varepsilon_1 + \varepsilon_2 = 0$.

Результаты численного решения дисперсионного уравнения в случае широкого диэлектрического зазора приведены на рис. 5. При этом были выбраны следующие значения параметров: $a=1\,\mathrm{m},~\Lambda=0.1,~B_0=50\,\mathrm{kGs},~m=3.$

Заключение

Таким образом, в настоящей работе исследованы дисперсионные свойства необыкновенных электромагнитных колебаний, распространяющихся по азимуту вблизи границы замагниченной плазмы, частично заполняющей цилиндрический волновод. Изучены распределение полей (см. (7), (9) и рис. 1) и зависимость собственной частоты АПВ (см. (14), (15) и рис. 2–5) от параметров волноведущей структуры.

В качестве примера приведем расчет собственной частоты АПВ с m=-3, распространяющейся в полностью ионизованной гелиевой плазме при $a=10\,\mathrm{cm}$, $B_0=3000\,\mathrm{Gs}$, $T=1\,\mathrm{eV}$, $n_e=10^{10}\,\mathrm{cm}^{-3}$, $\Lambda=0.1$.

При этом частота АПВ $\omega=19\omega_{ci}=140\cdot 10^6\,{\rm s}^{-1},$ что много больше частоты столкновений $\nu\approx 30n_eT^{-3/2}\,{\rm s}^{-1}$ в холодной плазме.

Полученные результаты могут найти применение при проектировании приборов плазменной электроники, использующих замагниченную плазму в качестве элемента волноведущей структуры (см., например [7,8]).

Авторы признательны В.А. Гирка за полезное обсуждение результатов работы.

Работа выполнена при поддержке Научного физикотехнологического центра НАН и Минобразования Украины.

Список литературы

- [1] Гирка В.А., Гирка И.А., Кондратенко А.Н., Ткаченко В.И. // РЭ. 1988. Т. 33. № 5. С. 1031–1035.
- [2] Гирка В.А., Гирка И.А. // РЭ. 1991. Т. 36. № 10. С. 1997– 2004.
- [3] *Азаренков Н.А., Кондратенко А.Н., Остриков К.Н.* // Изв. вузов. Радиофизика. 1993. Т. 36. № 5. С. 335–389.
- [4] Гирка В.А., Гирка И.А., Ткаченко В.И. // ЖТФ. 1996. Т. 66. Вып. 4. С. 114–120.
- [5] Гирка В.А., Гирка И.А., Олефир В.П., Ткаченко В.И. // Письма в ЖТФ. 1991. Т. 17. Вып. 1. С. 87–91.
- [6] Кролл Н., Трайвелпис А. Основы физики плазмы. М.: Мир, 1975.
- [7] Karbushev N.I. // Book of Abstracts. 11th Intern. Conf. on High Power Particle Beams. Prague, 1996. P. 1–55.
- [8] Onishchenko I.N., Balakirev V.A., Korostelev A.M. et al. // Ibid. P. 1–61.